PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-241913

(43) Date of publication of application: 17.09.1996

(51)Int.Cl.

H01L 21/60

(21)Application number: 07-045372

(71)Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

06.03.1995

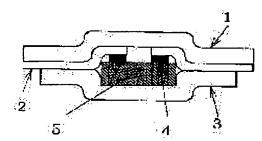
(72)Inventor: TANAKA SATOSHI

(54) SEMICONDUCTOR PACKAGE MATERIAL AND SEMICONDUCTOR PACKAGE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a semiconductor package with a simple configuration by preventing a sealing resin from being peeled off or cracked.

CONSTITUTION: In a semiconductor package 10, a wiring pattern 2 is formed toward the outside from a part for mounting a chip and a second insulation film 3 is adhered and laminated so that it covers a part other than the edge portion outside the pattern 2. The first and second insulation films 1 and 3 are $100\mu m$ or less thick and the & pattern 2 is a plating layer which is $20\mu m$ or less thick or a printed layer by a conductive paste and a lamination body where they are laminated is flexible.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-241913

(43)公開日 平成8年(1996)9月17日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

HO1L 21/60

3 1 1

H01L 21/60

311W

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平7-45372

平成7年(1995)3月6日

(71)出願人 000003193-

凸版印刷株式会社

東京都台東区台東1丁目5番1号

(72)発明者 田中 聡

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印

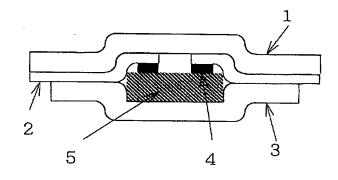
刷株式会社内

(54) 【発明の名称】 半導体パッケージ材料および半導体パッケージ

(57)【要約】

【目的】封止樹脂の剥離やクラックの発生が防止され、 簡便な構成の半導体パッケージを提供する。

【構成】チップの搭載箇所から外側に向かって、配線パ ターンが形成され、チップが樹脂封止されていない第1 の絶縁性フィルムに、第2の絶縁性フィルムを、前記パ ターンの外側の端部以外を被覆するように、貼着・積層 してなる構成の半導体パッケージ。第1・第2の絶縁性 フィルムは、厚さ100μm以下であり、配線パターン は、厚さ20μm以下のメッキ層、あるいは導電性ペー ストによる印刷層であり、それらが貼り合わされた積層 体が可撓性を有する構成。



【特許請求の範囲】

【請求項1】表面に、半導体集積回路素子が搭載される 箇所から外側に向かって、配線パターンが形成された第 1の絶縁性フィルムと、

1

前記パターンの外側の端部以外を被覆する面積の第2の 絶縁性フィルムと、からなる半導体パッケージ材料。

【請求項2】第1・第2の絶縁性フィルムは、厚さ10 0 μ m以下であり、

配線パターンは、厚さ20μm以下のメッキ層、あるい は導電性ペーストによる印刷層であり、

それらが貼り合わされた積層体が可撓性を有する請求項 1記載の半導体パッケージ材料。

【請求項3】半導体集積回路素子が搭載・接続された第 1の絶縁性フィルムに、第2の絶縁性フィルムを貼着・ 積層してなる構成の半導体パッケージであって、

第2の絶縁性フィルムが、第1の絶縁性フィルムに形成 された配線パターンの外側のパターン端部のみを被覆せ ず、前記端部が露出されており、

前記素子が樹脂封止されていない構成の請求項1または 請求項2記載の半導体パッケージ材料を用いた半導体パ 20 ッケージ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体集積回路素子 (以下、チップと称する)を搭載・接続し、プリント配 線基板などの外部回路に接続されて用いられる半導体装 置に関する。

[0002]

【従来の技術】前記半導体装置としては、以下の①~③ に例示するタイプのものが、一般的に普及している。

【0003】**②**リードフレームやフィルムキャリアにチ ップを搭載・接続した後、チップを含む領域を樹脂封止 してなる半導体装置。以下、この種の装置をプラスチッ クパッケージと称する。

【 0 0 0 4 】 ②チップを含む領域を、樹脂による封止で はなく、AlN板等のセラミック板で密閉してなる半導 体装置。以下、この種の装置をセラミックパッケージと 称する。

【0005】近年、1つの前記装置(パッケージ)内 に、複数個のチップを搭載・接続し、これまで以上に高 40 機能化・小型化の要求への対応が図られた装置として、 マルチチップモジュール (MCM) への期待が高まって

【0006】 3MCMの形態の1つとして、複数個のチ ップを搭載・接続したプリント配線基板を標準パッケー ジとし、前記パッケージを外部回路に接続するタイプの ものもある。配線基板としては、エポキシ系などの樹脂 基板をベース材料とするものや、セラミックをベース材 料とするものなどがある。実用に際しては、最外面に搭 載・接続したチップが露出しないように、チップを含む 50

領域を樹脂封止することになる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】 2のセラミックパッケ ージは、パッケージの作製が容易ではなく、コストが高 くかかる上に、パッケージの容積(特に、セラミック板 の厚みによる上下方向)がかさばる。

【0008】③のMCMも、ベース材料の樹脂基板(通 常、剛性を付与するために、ガラス繊維にエポキシ系樹 脂などを含浸させた基板)の厚みに依存し、上下方向の 10 容積がかさばる。

【0009】また、チップを含む領域を樹脂封止するこ とになる $\mathbf{0}$ のプラスチックパッケージ($\mathbf{3}$ の形態のもの も含む)では、封止樹脂とチップ(およびベース材料) との熱膨張率の違いにより、封止樹脂の剥離や、封止樹 脂やチップへのクラック発生などの問題を有している。

【0010】本発明は、封止樹脂の剥離やクラックの発 生が防止され、簡便な構成の半導体パッケージを提供す ることを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、表面に、チップが搭載される箇所から外側に向かっ て、配線パターンが形成された第1の絶縁性フィルム と、前記パターンの外側の端部以外を被覆する面積の第 2の絶縁性フィルムと、からなる半導体パッケージ材料 である。

【0012】請求項2に記載の発明は、第1・第2の絶 縁性フィルムは、厚さ100μm以下であり、配線パタ ーンは、厚さ20μm以下のメッキ層、あるいは導電性 ペーストによる印刷層であり、それらが貼り合わされた 積層体が可撓性を有する請求項1記載の半導体パッケー ジ材料である。

【0013】請求項3に記載の発明は、請求項1または 2記載の半導体パッケージ材料を用い、チップを搭載・ 接続してなる半導体パッケージであって、チップが搭載 ・接続された第1の絶縁性フィルムに、第2の絶縁性フ ィルムを貼着・積層してなり、第2の絶縁性フィルム が、第1の絶縁性フィルムに形成された配線パターンの 外側のパターン端部のみを被覆せず、前記端部が露出さ れており、前記素子が樹脂封止されていない構成であ

【0014】本発明にて用いられる絶縁性フィルムとし ては、例えばポリイミドのような、柔軟性や耐熱性・耐 食性のある樹脂フィルムが適当である。

【0015】配線パターンの形成にあたっては、導電性 ペーストを用いたスクリーン印刷や、無電解鍍金・スパ ッタリング・貼り合わせにより形成された導体層をフォ トエッチング法などによりパターン形成することが適当 である。この場合、貼り合わされたパッケージ材料が可 撓性を有するように、フォトエッチング法などによりパ ターニングされる導体層としては、厚さ20μm以下で

3

あることが望ましく、特に、可撓性の点から銅メッキ層 が適当である。

[0016]

【作用】チップを搭載・接続してなる半導体パッケージが、配線パターンが形成された第1の絶縁性フィルムに、第2の絶縁性フィルムを貼着・積層してなる構成であり、樹脂封止を必要としないプラスチックパッケージであるため、封止樹脂の剥離や、封止樹脂やチップへのクラックの発生などの問題が起こらない。

【0017】また、前記パッケージは、第2の絶縁性フィルムが、第1の絶縁性フィルムに形成された配線パターンの外側のパターン端部のみを被覆せず、前記端部が露出された構成であるため、露出された前記端部を接続端子として、外部回路(プリント配線回路など)に接続することが可能である。

【0018】さらに、配線パターンが、厚さ20μm以下のメッキ層、あるいは導電性ペーストによる印刷層であるため、配線間のピッチを小さくすることができ、高密度の配線パターンを形成することが可能である。

【0019】加えて、ベース材料がフィルムであるため、フィルムキャリア(TAB)同様に、リール・トゥ・リールの生産が可能である。

[0020]

【実施例】以下、図面を参照して、実施例を説明する。

【0021】図1は、半導体パッケージ10の断面説明図であり、図2は、配線パターンが形成された第1の絶縁性フィルムを示す平面図である。

【0022】第1の絶縁性フィルム1,第2の絶縁性フィルム3は、厚さ100μmのポリイミドフィルムである。

【0023】配線パターン2は、前記フィルム1上に無電解メッキにより形成した導体層(厚さ20μmの銅メッキ層)をフォトエッチング法によりパターニングした。

【0024】配線パターン2の内側先端部に、チップ4の電極パッド5と接続するためのハンダ部を形成した。 前記ハンダ部は、高融点ハンダをスクリーン印刷法によって前記先端部のみに選択的に形成した。(図示せず)

【0025】前記フィルム1上に、配線パターン2の内*

* 側先端部のハンダ部とチップ4の電極パッド5とが接合するように、チップ4を搭載した後、280℃のリフロー法によりフィルム1とチップ4とを接続する。

【0026】次いで、第2の絶縁性フィルム3を、前記フィルム1のチップ4が搭載・接続された側に貼着・積層する。貼着にあたっては、接着剤(図示せず)を用いて、配線パターン2の外側先端部のみを被覆しないようにし、前記端部が露出された構成とする。

【0027】前記パッケージ10を、そのままの状態でプリント配線回路などの外部回路に接続しても良いし、または、図4に示すように、前記パッケージ10をリードフレーム6と接続した上で、リードフレームを介して外部回路に接続しても良い。

【0028】リードフレームを介する場合は、アイランド(チップ搭載部)を有さない構成のリードフレームのインナーリード先端に、露出された配線パターン2の外側先端部をリフロー法などによって接続する。

【0029】また、本発明は本実施例に限定されるものではなく、図3に示すように、複数のチップを搭載・接続しても良い。

[0030]

【発明の効果】簡便でコンパクトな構成であり、封止樹脂の剥離やクラックの発生が防止された構成の半導体パッケージが提供された。

[0031]

【図面の簡単な説明】

【図1】半導体パッケージの断面説明図。

【図2】第1の絶縁性フィルムを示す平面図。

【図3】半導体パッケージの他例を示す断面説明図。

【図4】半導体パッケージの他例を示す断面説明図。

【符号の説明】

30

1…第1の絶縁性フィルム

2…配線パターン

3…第2の絶縁性フィルム

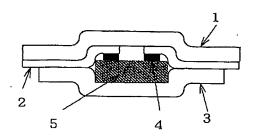
4…チップ

5…電極パッド

6…リードフレーム

10…半導体パッケージ

【図1】



【図3】

